

■ナノインプリント用モールド

タイプ	型式	材質	パタン種	パタン寸法(Duty比)等	高さ(深さ)	基板外形等
標準タイプ	NIM-PH350	石英	ライン、ドット、ホール(混載)	ライン:350nm~10μm/10水準、ホール・ドット: 500nm~10μm/8水準、(1:1、1:2、1:5)	350nm	外形: 10mm□、厚さ: 0.625mm、パタン領域: 9mm□
	NIM-PHL45	石英	ライン凹	45、60、80、100nm/4水準(1:1、1:5)	100nm	外形: 10mm□、厚さ: 1mm、パタン領域: 2mmx3mm(500nmL&S(1:5) 7mm□)
	NIM-PHL80	石英	ライン凹	80nm~3μm/11水準(1:1、1:2、1:3、1:10)	200nm	外形: 10mm□、厚さ: 0.625mm、パタン領域: 9mm□
	NIM-PHH100	石英	ホール凹	100nm~3μm/9水準(1:1、1:2、1:3)	200nm	
高解像タイプ	NIM-100D RESO	石英	ドット凸	100nm~3μm/9水準(1:1、1:2、1:3)	100nm	
	NIM-100L RESO凸	石英	ライン凸	100nm~3μm/9水準(1:1、1:2、1:3、1:10)	200nm	
	NIM-80L RESO (Si)	Si	ライン凹	80nm~3μm/11水準(1:1、1:2、1:3、1:10)	200nm	
	NIM-100D RESO (Si)	Si	ドット凸	100nm~3μm/9水準(1:1、1:2、1:3)	100nm	
	NIM-100H RESO (Si)	Si	ホール凹	100nm~3μm/9水準(1:1、1:2、1:3)	200nm	
	NIM-100L RESO凸 (Si)	Si	ライン凸	100nm~3μm/9水準(1:1、1:2、1:3、1:10)	200nm	
単一タイプ	NIM-100UL	石英	ライン凹	100nm(1:1)	200nm	外形: 20mm□、厚さ: 0.625mm、 パタン領域: 8mm□×1(-150UL除く) 8mm□×2(-150UL)
	NIM-100UH	石英	ホール凹	100nm(1:1)、正方配列	200nm	
	NIM-100UD	石英	ドット凸	100nm(1:1)、正方配列	100nm	
	NIM-150UL	石英	ライン凹	150nm、200nm(1:1)	200nm	
	NIM-1000UL	石英	ライン凹	1、2、4、8μm/4水準、(1:1)	1μm	外形: 20mm□、厚さ: 0.625mm、パタン領域: 6mm□×4
	NIM-100UL (Si)	Si	ライン凹	100nm(1:1)	200nm	外形: 20mm□、厚さ: 0.625mm、 パタン領域: 8mm□×1(-150UL除く) 8mm□×2(-150UL)
	NIM-100UH (Si)	Si	ホール凹	100nm(1:1)、正方配列	200nm	
	NIM-100UD (Si)	Si	ドット凸	100nm(1:1)、正方配列	100nm	
NIM-150UL (Si)	Si	ライン凹	150nm、200nm(1:1)	200nm		
Ni電鍍モールド	NIM-100L RESO (Ni)	Ni電鍍	ライン凸	100nm~3μm/9水準(1:1、1:2、1:3、1:10)	200nm	外形: 10mm□、厚さ: 0.3mm、パタン領域: 9mm□
マイクロレンズアレイ	MLA-P20S08	石英	凹型	ピッチ20μm、正方配列	8μm	外形: 20mm□、厚さ: 0.625mm、パタン領域: 10mm□
	MLA-P01S003	石英	凹型	ピッチ1μm、正方配列	300nm	外形: 15mm□、厚さ: 0.625mm、パタン領域: 5mm□
反射防止体パタン	MES-P270H350	Si	円錐状、凸型	ピッチ270nm、正三角形配列	350nm	外形: 100mmφ、厚さ: 0.625mm、パタン領域: 15mm□
	MES-P270H350/C	Si	円錐状、凸型	ピッチ270nm、正三角形配列	350nm	外形: 20mm□、厚さ: 0.625mm、パタン領域: 10mm□

■測長スケール

タイプ	型式	用途	傾斜角	パタン種・パタン寸法等	基板材質	基板外形等
垂直タイプ	AS100P-D	長さ校正、プローブ形状評価	90度	パタン種類: 1:1 ライン&スペース凸タイプ ライン(凸部)幅: 50nm~250nm パタン深さ: 125nm±20% パタン領域: 200μm□	Si	外形: 10mm□、厚さ: 0.525mm
	AS100P-U/T	長さ校正、プローブ形状評価	90度	パタン種類: 1:1 ライン&スペース凸タイプ ピッチ幅: 100nm(校正証明書添付) パタン深さ: 100nm±20% パタン領域: 250μm□		
傾斜タイプ	AS200P-A	角度校正	54.7度	パタン種類: 400nm、200nm、100nmライン&スペース、400nmグリッド ライン(凸部)幅: 100nm~400nm パタン深さ: 100nm~200nm パタン領域: 184μm□×4種		

注意: 本表に記載された仕様等は代表値であり、保証することを意味するものではありません。また、仕様等は製品改良のため、お断りなく変更することがありますのでご了承下さい。
一部の商品については受注生産で対応しておりますので、納期は弊社担当までお問い合わせください。

■Ta製フレネルゾーンプレート

品名	型式	最外周 パターン幅(nm)	直径 (μm)	ゾーン数	パタン 材質	Ta膜厚 (nm)	メンブレン構造	基板材質	基板外形等
Ta製フレネルゾーンプレート	FZP-S38/84	38	84	550	Ta	160	2層構造 (Ru 0.02 μm /SiN 0.15 μm)	Si	外形: 5mm \square 、厚さ: 0.625mm
	FZP-S50/80	50	80	400		250	2層構造 (Ru 0.02 μm /SiN 0.2 μm)		外形: 10mm \square 、厚さ: 1mm
	FZP-S40/155	40	155	968		200	2層構造 (Ru 0.02 μm /SiN 2 μm)		
	FZP-S50/330	50	330	1650		400	2層構造 (Ru 0.02 μm /SiN 1 μm)		
	FZP-S86/416	86	416	1200		700	2層構造 (Ru 0.02 μm /SiN 2 μm)		
	FZP-100/155	100	155	388		800	2層構造 (Ru 0.02 μm /SiN 2 μm)		
	FZP-173/208	173	208	300		1000	単層構造 (SiN 2 μm)		
	FZP-200/206	200	206	255		1600	2層構造 (Ru 0.02 μm /SiN 2 μm)		
	FZP-C234/2500	234	2500	2670		150	2層構造 (Ru 0.02 μm /SiC 0.2 μm)		

■FZP用センタービームストップ

品名	型式	最小パタン 寸法	ストップ 材質	Au厚さ	メンブレン構造	メンブレン サイズ	基板材質	基板外形等
FZP用センタービームストップ	CS-100/30-3.0W	100 μm ϕ	Au	30 μm	2層構造 (SiC 2 μm /SiN 0.3 μm)	3mm \square	Si	外形: 10mm \square 、厚さ: 1mm
	CS-75/30-3.0W	75 μm ϕ			2層構造 (SiC 2 μm /SiN 0.3 μm)			
	CS-50/30-3.0W	50 μm ϕ			2層構造 (SiC 2 μm /SiN 0.3 μm)			
	CS-40/30-3.0W	40 μm ϕ			2層構造 (SiC 2 μm /SiN 0.3 μm)			
	CS-100/50-3.0W	100 μm ϕ		50 μm	2層構造 (SiC 2 μm /SiN 0.3 μm)			
	CS-75/50-3.0W	75 μm ϕ			2層構造 (SiC 2 μm /SiN 0.3 μm)			

■X線チャート

タイプ	型式	パタン種	最小 パタン寸法	パタン 材質	Ta膜厚	メンブレン構造	パタン領域	メンブレン サイズ	基板 材質	基板外形等
標準タイプ	XRESO-100	放射状、L&S	100nm	Ta	1 μm	2層構造 (Ru 0.02 μm /SiN 2 μm)	250 μm \times 300 μm	1mm \square	Si	外形: 10mm \square 、厚さ: 1mm
厚膜高解像タイプ	XRESO-50HC	放射状、L&S、 ホール	50nm		0.5 μm	3層構造 (Ru 0.02 μm /SiC 0.2 μm /SiN 0.05 μm)	300 μm \times 300 μm			
超高解像度タイプ	XRESO-20		20nm		0.1 μm	3層構造 (Ru 0.02 μm /SiC 0.2 μm /SiN 0.05 μm)	300 μm \times 300 μm			

■メンブレン

品名	型式	メンブレン 材質	メンブレン サイズ(mm)	メンブレン 膜厚 (nm)	基板材質	外形 (mm)	基板厚 (mm)
SiNメンブレン	MEM-N03001/7.5M	SiN	3 \times 3	100	Si	7.5 \times 7.5	0.625
	MEM-N03002/7.5M		3 \times 3	200			
	MEM-N02001/10M		2 \times 2	100			
	MEM-N03002/10M		3 \times 3	200			
	MEM-N020027/10M		2 \times 2	270			
	MEM-N0302/10M		3 \times 3	2000			
	MEM-N0301/10M		3 \times 3	1000			
SiCメンブレン	MEM-C03003/10M	SiC	3 \times 3	300	Si	10 \times 10	0.625
	MEM-C0301/10M		3 \times 3	1000			

●お問い合わせ先
 NTTアドバンステクノロジー株式会社
 グローバル事業本部 営業部門
 Tel: 046-270-2075 Fax: 046-270-2077
 〒243-0124 神奈川県厚木市森の里若宮3-1 NTT厚木研究開発センター内
 E-mail: nano-sales@ml.ntt-at.co.jp
 http://keytech.ntt-at.co.jp/nano/

注意: 本表に記載された仕様等は代表値であり、保証することを意味するものではありません。また、仕様等は製品改良のため、お断りなく変更することがありますのでご了承下さい。
 一部の商品については受注生産で対応しておりますので、納期は弊社担当までお問い合わせください。